

平成 24 年 11 月 12 日

委員各位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 78 回委員会・第 82 回研究会 開催案内

日時：平成 24 年 12 月 7 日（金）・8 日（土）

委員会：8 日 12:10-13:00

研究会：7 日 16:00-18:30

8 日 09:00-12:00 13:00-15:00

意見交換会：7 日 19:30-21:30

場所：橿原ロイヤルホテル <http://www.daiwaresort.jp/kashihara/index.html/>

〒634-0063 奈良県橿原市久米町 652 番地の 2 TEL：0744-28-6636

委員会

議題：

- 1) 前回第 77 回委員会議事要録承認について
- 2) 委員の異動について
- 3) 次回第 83 回研究会について
- 4) 平成 25 年度の研究会計画について
- 5) その他

報告事項：

- 1) 第 39 回産学協力研究委員会委員長会議(11/6 開催)について
- 2) ワイドギャップ半導体スクールの報告(10/25-27 開催)について
- 3) 「技術の伝承等成果の取りまとめ」刊行事業について
- 4) 国際会議 IWN2012(10/14-19 開催, 本委員会共催)について
- 6) APWS2013(台湾 5/12-15 開催予定)について
- 7) その他

研究会 主 題：「テーマ:ワイドギャップ半導体を支えるバルク成長の進展」

12/7(金)

委員長挨拶・企画の趣旨説明 (16:00 ~ 16:10)

- ① 特別講演「飛鳥・藤原の都ー古代律令国家の原点ー」 16:00-16:40

橿原考古学研究所 鶴見泰寿

- ② 基調講演「サファイア基板の大型化の現状と研究動向」 16:40-17:30

東北大学、福田結晶技術研究所 福田 承生

- ③ 基調講演「バルクを目指したワイドギャップ半導体の HVPE 成長 17:30-18:20

-熱力学解析から結晶成長まで-

東京農工大学 額綱 明伯

12/8(土)

- ④ 「アモノサーマル法による GaN バルク結晶成長」 09:00-09:40

三菱化学 三川 豊、斉藤 真、川端 紳一郎、鎌田 和典、鏡谷 勇二、藤澤 英夫

- ⑤ 「HVPE 法 GaN 結晶における転位の制御」09:40-10:20

古河機械金属 碓井 彰

休憩(10:20-10:40)

- ⑥ 「HVPE 法による AlN 厚膜成長の現状と展望」10:40-11:20

三重大学 三宅 秀人

- ⑦ 「酸化ガリウムの現状とデバイス展開」 11:20-12:00

タムラ製作所 倉又 朗人

委員会／昼食(12:10-13:00)

- ⑧ 「パワーデバイス用 SiC 単結晶基板開発の現状と展望」13:00-13:40

関西学院大学 大谷 昇

- ⑨ 「触媒表面基準エッチング法による単結晶 SiC,GaN の表面加工」13:40-14:20

大阪大学 山内 和人

- ⑩ 「パワーデバイス目指したダイヤモンド及びデバイスの先導研究」14:20-15:00

産業技術総合研究所 鹿田 真一

<追記>

1. 12月8日(土)の委員会では、ご出席の委員に昼食をご用意いたします。
2. 12月7日(金)の研究会終了後に意見交換会を行います。宿泊なしで意見交換会出席ご希望の方は、幹事の菊池(miyake@elec.mie-u.ac.jp)までご相談ください。
3. **委員会・研究会**へのご出欠回答を、**11月22日(木)までに**日本学術振興会研究事業課 檜崎様(jigyouka09@jsps.go.jp)にご連絡くださいますようお願いいたします。
4. **宿泊**につきましては、添付の申込書により**直接(株)アートツーリスト**へお申し込みください。締切は**11月22日(木)**です。